

	<h2 style="color: red;">FDC655BN_NBNN007</h2> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FDC655BN_NBNN007</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 6.3A SUPERSOT6</p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDC655BN_NBNN007
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 6.3A SUPERSOT6
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	SuperSOT™-6
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	25 mOhm @ 6.3A, 10V
Verlustleistung (max)	800mW
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	620pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 6.3A 800mW Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.3A

FDC655BN\_NBNN007 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDC655BN\_NBNN007-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDC655BN\_NBNN007 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ FDC655BN\_NBNN007 E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FDC6561</b> FAIRCHILD FDC6561 FAIRCHILD</p>	 <p><b>FDC655AN_NL</b> FSC FDC655AN_NL FSC</p>	 <p><b>FDC6561AN-NL</b> FAIRCHILD FDC6561AN-NL FAIRCHILD</p>	 <p><b>FDC655BN</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 6.3A SSOT-6</p>
 <p><b>FDC6561AN</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 2.5A SSOT6</p>	 <p><b>FDC6561AN</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 2.5A SSOT6</p>	 <p><b>FDC655BN</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 6.3A SSOT-6</p>	 <p><b>FDC655BN-NL</b> FAIRCHL FDC655BN-NL FAIRCHL</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDC655BN_NBNN007 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDC655BN_NBNN007 Datenblatt	FDC655BN_NBNN007-Datenblätter	FDC655BN_NBNN007 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDC655BN_NBNN007
FDC655BN_NBNN007 Electronic	FDC655BN_NBNN007-Komponenten	FDC655BN_NBNN007-Verteiler	FDC655BN_NBNN007-Bild	FDC655BN_NBNN007-Teil
FDC655BN_NBNN007 Preis	FDC655BN_NBNN007 Hersteller	FDC655BN_NBNN007 Bild	FDC655BN_NBNN007 Aktie	FDC655BN_NBNN007 Inventar
FDC655BN_NBNN007 Neu	FDC655BN_NBNN007 Original	FDC655BN_NBNN007 garantiert	FDC655BN_NBNN007 RFQ	FDC655BN_NBNN007 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited